

**Физика и техника полупроводников,
2020, том 54, выпуск 6**

Электронные свойства полупроводников

Сардарлы Р.М., Салманов Ф.Т., Алиева Н.А., Аббаслы Р.М.

Импедансные характеристики γ -облученных твердых растворов $(\text{TlGaSe}_2)_{1-x}(\text{TlInS}_2)_x$ 511

Аванесян В.Т., Жаркой А.Б., Ракина А.В.

Особенности переноса заряда в легированных слоях сульфида цинка в низкочастотном переменном электрическом поле 519

Нифтиев Н.Н., Мамедов Ф.М., Мурадов М.Б.

Электропроводность FeGaInSe_4 на переменном токе 523

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Гусейналиев М.Г., Ясинова С.Н., Джалилли Д.Н., Мехтиева С.И.

Оптические свойства и критические точки наноструктурированных тонких пленок PbSe 527

Priya V.L., Prithivikumaran N.

Influence of Ni-Doping in ZnO Thin Films Coated on Porous Silicon Substrates and ZnO/PS Based Hetero-junction Diodes 532

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Галашев А.Е., Воробьев А.С.

Электронные свойства пленок силицена, подвергнутых нейтронному легированию 533

Dubrovskii V.G., Reznik R.R., Kryzhanovskaya N.V., Shtrom I.V., Ubyivovk E.D., Soshnikov I.P., Cirlin G.E.

MBE-Grown $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ Nanowires with 50% Composition 542

Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Амасев Д.В., Михалевич В.Г., Тамеев А.Р., Саитов Ш.Р., Казанский А.Г.

Формирование двухфазной структуры в металлоорганическом перовските $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ 543

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Шутаев В.А., Гребенщикова Е.А., Сидоров В.Г., Компан М.Е., Яковлев Ю.П.

Влияние водорода на импеданс структур Pd/оксид/InP 547

Углеродные системы

Рутьков Е.В., Афанасьева Е.Ю., Галль Н.Р.

Транспортные процессы с участием атомов углерода между поверхностью и объемом родия при образовании и разрушении графена 552

Физика полупроводниковых приборов

Асадчиков В.Е., Дьячкова И.Г., Золотов Д.А., Чуховский Ф.Н., Никитина Е.В.

Коррекция характеристик кремниевых фотодиодов путем применения ионной имплантации 557

Марков Л.К., Смирнова И.П., Кукушкин М.В., Павлюченко А.С.

Модификация рельефа n-поверхности AlGaInN -светодиодов изменением состава газовой смеси при реактивном ионном травлении 564

Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Моисеев Э.И., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Надточий А.М., Максимов М.В.

Предельная температура генерации микродисковых лазеров 570

Калыгина В.М., Алмаев А.В., Новиков В.А., Петрова Ю.С. Солнечно-слепые детекторы УФ-излучения на основе пленок beta-Ga₂O₃	575
Калядин А.Е., Штельмах К.Ф., Аруев П.Н., Забродский В.В., Карабешкин К.В., Шек Е.И., Соболев Н.А. Кремниевые светодиоды с люминесценцией (113) дефектов	580
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Laifi J., Bchetnia A. Impact of Carrier Gas on the GaN Layers Properties Grown on (001) and (11n) GaAs Substrates by AP-MOVPE: Comparative Study	585
Mahmoodnia H., Salehi A., Mastelaro V.R. GaAs Semiconductor Passivated by (NH₄)₂S_x: Analysis of Different Passivation Methods by Electrical Characteristics and XPS Measurements	586